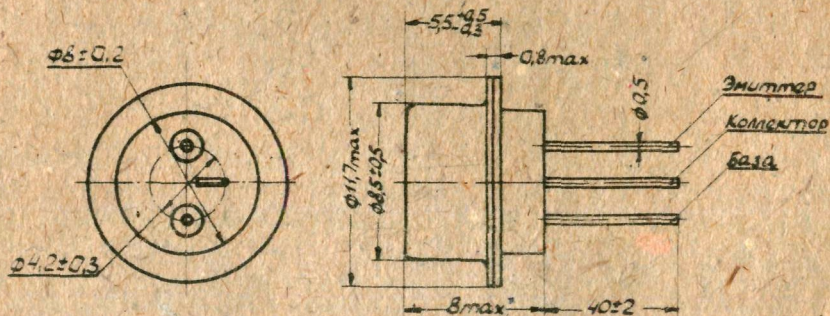


изв. №1 от 4/IV 69



Транзисторы кремниевые типов:
ПЗО70С, ПЗО7А0С, ПЗО7Б0С, ПЗО7В0С, ПЗО7Г0С, ПЗО80С, ПЗО90С

Габаритный чертёж ЩБЗ.365.028Г
Технические условия ЖКЗ.365.176ТУ



Общие данные

Тип: транзисторы кремниевые диффузионные п-р-п типов: ПЗО70С, ПЗО7А0С, ПЗО7Б0С, ПЗО7В0С, ПЗО7Г0С, ПЗО80С, ПЗО90С. Конструкция транзисторов герметична и обеспечивает сохранение целостности конструкции и электрических параметров в пределах норм в условиях воздействия на них:

постоянных ускорений до $150g$;

ударных ускорений до $150g$;

вибрационных ускорений до $15g$;

в диапазоне частот 5-2500гц

Тип транзистора	Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер	Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером	Сопротивление насыщения
	$U_{кз} (В)$	β_0	$R_s (ом)$
ПЗ070С	80	16-50	≤ 100
ПЗ07А0С	80	30-90	≤ 130
ПЗ07Б0С	80	50-150	≤ 330
ПЗ07В0С	60	50-150	≤ 130
ПЗ07Г0С	80	16-50	≤ 250
ПЗ080С	120	30-90	≤ 330
ПЗ090С	120	16-50	≤ 130

Таблица предельно-допустимых значений

Наименование параметров	Обозначение	Ед. измерения	Норма				
			ПЗ070С ПЗ07А0С	ПЗ07Б0С ПЗ07Г0С	ПЗ07В0С	ПЗ080С	ПЗ090С
Наибольший ток эмиттера	$I_{э макс.}$	мА	30	15	30	15	30
Наибольший ток коллектора	$I_{к макс.}$	мА	30	15	30	15	30
Максимальный ток коллектора в импульсе	$I_{к имп.}$	мА	120	120	120	120	120
Обратное напряжение эмиттер-база	$U_{эб макс.}$	В	3	3	3	3	3
Напряжение коллектор-база	$U_{кб макс.}$	В	80	80	60	120	120
Напряжение коллектор-эмиттер ($R_{эб}=10 ком$) [*]	$U_{кэ}$	В	80	80	60	120	120

Примечание: Температура окружающей среды $-60^{\circ}C \div +120^{\circ}C$

^{*} Допускается включение сопротивления в цепи базы (R_B) не более 100 ком до $T = +60^{\circ}C$, если сопротивление в цепи эмиттера $R_3 = R_B$.

Указания по эксплуатации и монтажу

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5мм от корпуса транзистора.

Пайку следует производить паяльником мощностью 50-60 Вт в течение не более 10 секунд (температура пайки не должна превышать 260°C). При пайке должен быть обеспечен надёжный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора. Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 5мм от корпуса путём погружения не более, чем на 10 секунд в расплавленный припой с t° не выше 260°C .

При включении транзистора в цепь базовый контакт должен присоединяться первым, а отключаться последним.

В процессе работы не разрешается превосходить предельно-допустимые значения токов, напряжений и мощности во всём интервале температур, не рекомендуется работа в совмещённых режимах.

При эксплуатации транзисторов в условиях механических ускорений более $2g$, транзисторы необходимо крепить за корпус.

При изгибе вывода на расстоянии от $3^{\frac{1}{2}}$ до 5 мм необходимо применять специальные шаблоны.

4 СЕИ 1069

Дата выпуска

Контролёр ОТК

